



GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

GNV321/358/324A

#### 1、概述

GNV321/358/324A是一款轨到轨输入、输出电压反馈、低功耗的运算放大 器。其拥有较宽的输入共模电压和输出摆幅;最低工作电压可达 2.1V,最大 工作电压推荐为 5.5V。各类袖珍或便携式立体声收录机中作功率放大器。

GNV321/358/324A具有在每路运放约45uA功耗的情况下,能提供1.1MHz 增益带宽积。具有极低的输入偏置电流(约10pA级),可用于集成,光电二极 管放大器和压电传感器。轨到轨输入和输出缓冲也用于单电源系统中的特定 集成电路设计。该系列放大器的应用包括安全监测,便携式设备,电池和电 源,供应的控制,低功耗传感器系统中的信号处理和接口。

#### 主要特点

- · 低功耗
- · 轨到轨输入和输出,典型 0.8mv 的 Vos
- · 单位增益稳定
- · 增益带宽积 1.1MHz
- · 低输入偏置电流: 10pA 级, <1nA
- · 2.1V~5.5V的工作电压
- · 低工作电流: 45uA 每通道

#### 应用领域

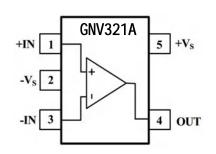
- · ASIC 输入和输出运放
- · 传感器接口
- · 压电传感放大器
- · 医疗器械
- . 移动通信
- · 音频输出
- · 便携式系统
- · 烟雾探测器、笔记本电脑、PCMCIA卡
- · 电池供电设备
- · DSP 接口

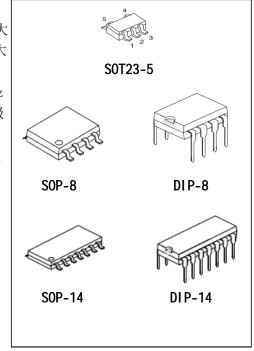
#### 封装形式

GNV321A	S0T23-5	3000PCS/盘	6000PCS/盒	48000PCS/箱
GNV358A	SOP-8	4000PCS/盘	8000PCS/盒	64000PCS/箱
GNV324A	SOP-14	4000PCD/盘	8000PCS/盒	64000PCS/箱

#### 2、引脚说明

#### 2.1、GNV321A引脚说明





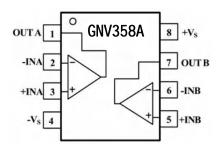


# **旌芯半导体科技(上海)有限公司** GN Semi conductor (Shanghai) Co., Ltd.

## GNV321/358/324A

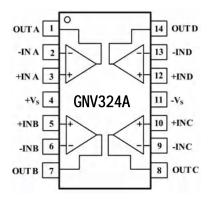
管脚序号	管脚名称	I/0	描述
1	+IN	I	正输入
2	-Vs	_	负电源
3	-IN	Ι	负输入
4	OUT	0	输出
5	+V <sub>S</sub>	_	正电源

#### 2.2、GNV358A引脚说明



管脚序号	管脚名称	I/0	描述
1	OUTA	0	输出A
2	-INA	I	负输入A
3	+INA	Ι	正输入A
4	-Vs	_	负电源
5	+INB	I	正输入B
6	-INB	I	负输入B
7	OUTB	0	输出B
8	+VS	_	正电源

#### 2.3、GNV324A引脚说明





GN Semi conductor (Shanghai) Co., Ltd.

### GNV321/358/324A

管脚序号	符号	I/0	功能	管脚序号	符号	I/0	功能
1	OUTA	0	输出 A	8	OUTC	0	输出 C
2	-INA	Ι	负输入 A	9	-INC	Ι	负输入C
3	+INA	Ι	正输入 A	10	+INC	Ι	正输入C
4	+Vs	_	正电源	11	-Vs	_	负电源
5	+INB	Ι	正输入 B	12	+IND	Ι	正输入 D
6	-INB	Ι	负输入 B	13	-IND	Ι	负输入 D
7	OUTB	0	输出 B	14	OUTD	0	输出 D

#### 3、电特性

#### 3.1、极限参数

供电电压(V+ to V-)	7.5V		
输入共模电压	(-VS) -0.5V to (+VS) +0.5V		
贮存温度	-50°C to +150°C		
结温	+150°C		
工作温度	-40°C to +85°C		
引线温度范围(焊接10秒)	260℃		

注意:超过以上极限值有可能造成芯片的永久性损坏。工作在极限值条件下,亦会影响器件的可靠性。静电放电 也会造成芯片的损坏,建议对集成电路做一定的预防措施。不遵守正确的搬运与安装上机,也会造成损坏。精密集成 电路可能更容易受到损坏,因为很小的参数变化可能会导致该器件不符合其公布的规格。

#### **3.2、电气特性: VS = +5V**(无特殊说明 At RL = 100kΩ connected to Vs/2, and V0UT = Vs/2, Ta=25℃)

参数	符号 测试条件			単位		
少效	71) 7	侧风亲什	Min	Тур	Max	<del>単</del> 似
输入失调电压	Vos		1	±0.8	±1.5	mV
输入偏置电流	IB		I	10	_	рA
输入失调电流	Ios		I	10	_	pА
输入共模电压	Vcm	VS=5.5V	I	0.1~+5.6	_	V
共模抑制比	CMRR	VS=5. 5V, VCM=−0. 1V~4V	62	70	ı	dB
7人(关)作师10		VS=5.5V, VCM=-0.1V∼5.6V	56	68	_	dB
开环增益	AOL	RL=5K Ω , Vo=0. 1V~4. 9V	70	80	_	dB
/1 ×1.×E III.	AOL	RL=100K $\Omega$ , Vo=0. 035V $\sim$ 4. 965V	80	84	_	dB
输入失调电压漂移	$\Delta$ VOS/ $\Delta$ T		I	2.7	ı	uV/℃
输出电压摆幅		RL=100K Ω	-	0.008	-	V
柳田石下江村		RL=10K Ω	_	0.08	-	V
输出电流	IOUT		18	30	_	mA
工作电压范围			2. 1	_	5. 5	V

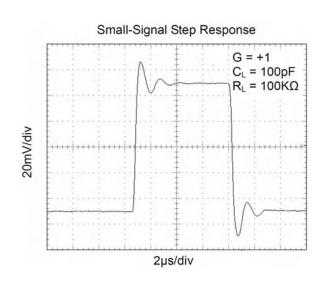


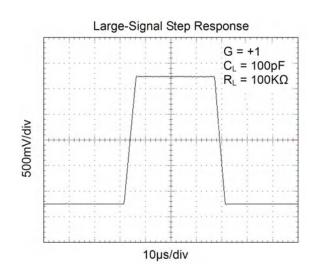
GN Semi conductor (Shanghai) Co., Ltd.

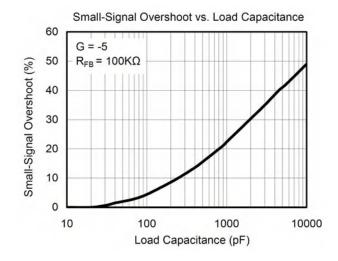
### GNV321/358/324A

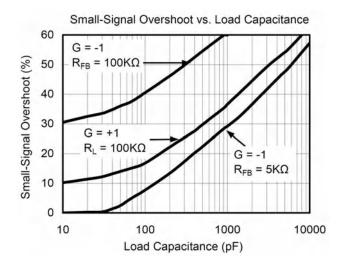
电源抑制比	PSRR	V <sub>S</sub> =+2.5V∼+5.5V, VCM=(-VS)+0.5V	60	80	-	dB
静态电流/Amplifier	IQ	IOUT=0	-	45	75	uA
增益带宽积	GBP	CL=100Pf	-	1. 1	_	MHz
转换速率	SR	G=+1,2V Output Step	-	0.5	-	V/us
电压噪声密度	en	f=1kHz	-	27	-	~\/ ///_
		f=10kHZ	_	20	_	nV <i>/√HZ</i>

#### **4、典型特性曲线 (**无特殊说明 TA = +25℃, VS = +5V, and RL = 100kΩ connected to Vs/2)





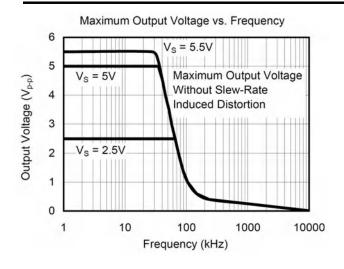


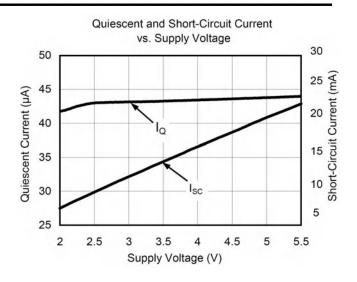


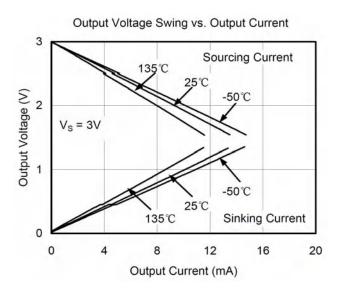


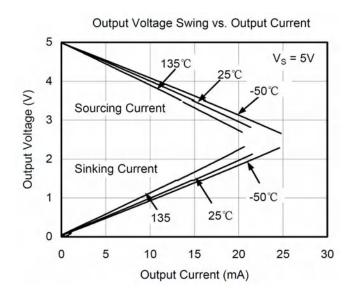
GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

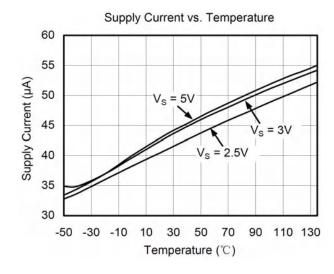
GNV321/358/324A

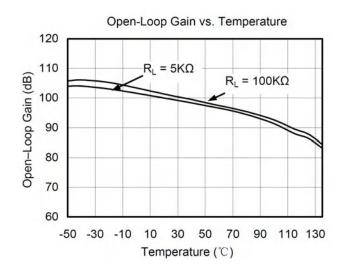






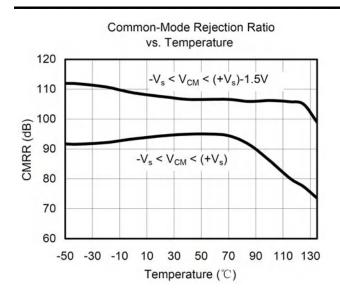


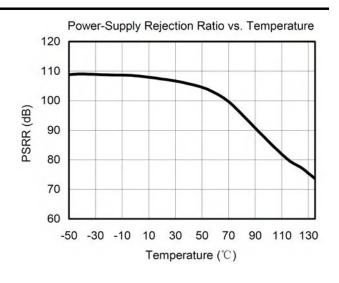




GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

GNV321/358/324A





#### 5、应用说明

#### 5.1、驱动容性负载

GNV321/358/324A单位增益下能直接驱动250pf电容(无振荡),单位增益跟随器(缓冲器)是对容性负载配置 最敏感的。直接驱动容性负载,减少了振铃放大器相位正确度,甚至引起振荡。若应用需要驱动更大的电容,则需 要在输出和电容之间使用一个隔离电阻,如图1。此隔离电阻Riso和电容负载CL需稳定增加,Riso值越大,输出也就 越稳定。注意,这种方法损失了最终的增益,因为Riso和负载进行了分压。

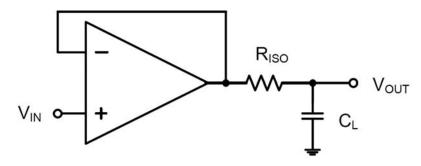


图1,驱动较大电容负载

一种改进的电路方式如图2,他提供的直流DC的精度和交流AC的稳定性,反向输入和输出端之间的反馈电阻Rf 保证直流的精度,CF和Riso连接在反向输入端和输出端之间,在高频率信号时,可以抵消一部分相位裕度的损失, 从而保证整个反馈回路中的相位裕度。

GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

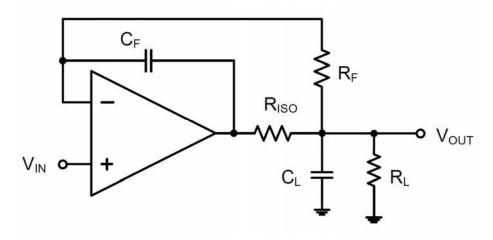


图2,直接驱动高电容,保证DC精度

对于没有缓冲配置的电路,有两种方法增益相位裕度,a)增加放大器的增益,b)在反馈电阻间并联一个电容 ,来抵消寄生电容。

#### 5.2、电源旁路和布局

GNV321/358/324A可工作于单电源2.1V~5.5V或双电源±1.05V~±2.75V。单电源下,旁路电容0.1uF应靠近电 源VDD引脚。双电源的情况下,VDD和VSS引脚都需接0.1uF的旁路电容。(都为陶瓷电容)2.2μF的钽电容可以增加更 好的性能。

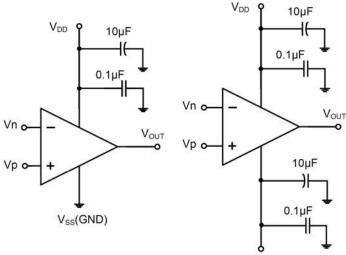


图3, 带有旁路电容的运放

#### 6、典型应用

#### 6.1、差分放大器

如图4所示电路, 若电阻相等, (R4 / R3 = R2 / R1), 那输出VOUT = (Vp - Vn) × R2 / R1 + VREF。

GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

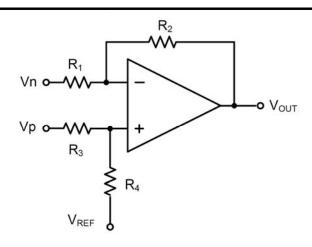


图4,差分放大器

#### 6.2、仪表放大器

如图5电路和图4功能相同,但是输入为高阻抗。

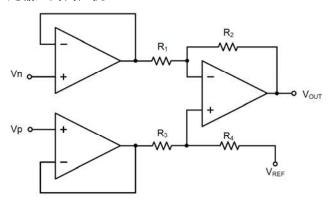


图5,精密放大电路

#### 6.3、低通有源滤波

如图6的低通滤波电路,拥有一个(-R2 / R1)直流增益,和在频率为1/2πR2C拐角-3dB。需确保滤波器在放大器 的带宽内。大反馈的电阻在高速时易伴随寄生电容,从而造成振荡等不良影响。保持尽可能低的电阻值,并考虑合 适的输出的负载。

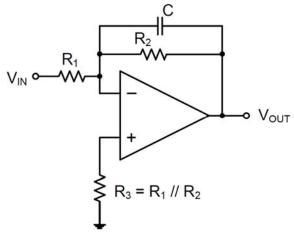
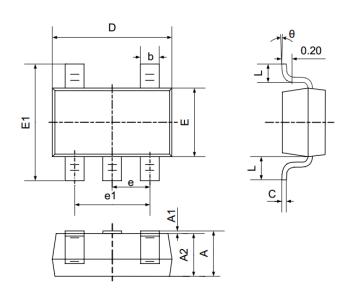


图6,低通滤波器

### GNV321/358/324A

### 7、封装尺寸与外形图

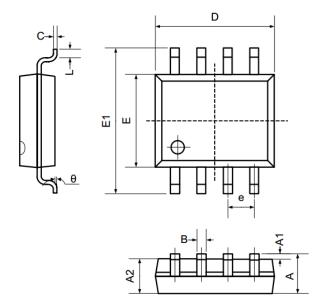
### 7.1、SOT23-5**外形图与封装尺寸**



Symbol		nsions imeters	Dimensions In Inches		
	Min	Max	Min	Max	
Α	1.050	1.250	0.041	0.049	
A1	0.000	0.100	0.000	0.004	
A2	1.050	1.150	0.041	0.045	
b	0.300	0.400	0.012	0.016	
С	0.100	0.200	0.004	0.008	
D	2.820	3.020	0.111	0.119	
E	1.500	1.700	0.059	0.067	
E1	2.650	2.950	0.104	0.116	
е	0.950	TYP	0.037	7TYP	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079	
L	0.700	REF	0.028	BREF	
L1	0.300	0.600	0.012	0.024	
θ	0°	8°	0°	8°	



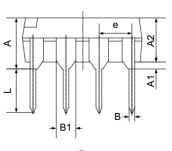
#### 7.2、SOP-8外形图与封装尺寸

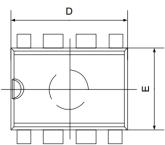


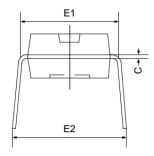
Symbol		nsions meters	Dimensions In Inches		
	Min	Max	Min	Max	
Α	1.350	1.750	0.053	0.069	
A1	0.100	0.250	0.004	0.010	
A2	1.350	1.550	0.053	0.061	
В	0.330	0.510	0.013	0.020	
С	0.190	0.250	0.007	0.010	
D	4.780	5.000	0.188	0.197	
E	3.800	4.000	0.150	0.157	
E1	5.800	6.300	0.228	0.248	
е	1.270TYP		0.050TYP		
L	0.400	1.270	0.016	0.050	
θ	0°	8°	0°	8°	

GNV321/358/324A

#### 7.3、DIP-8**外形图与封装尺寸**





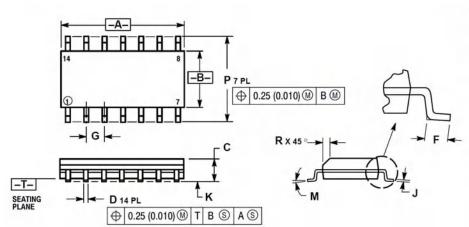


	Dimensiona Dimensiona						
	Dimer	nsions	Dimensions				
<b>Symbol</b>	In Milli	meters	In Inches				
	Min	Max	Min	Max			
Α	3.710	4.310	0.146	0.170			
A1	0.510		0.020				
A2	3.200	3.600	0.126	0.142			
В	0.380	0.570	0.015	0.022			
B1	1.524	(BSC)	0.060(BSC)				
С	0.204	0.360	0.008	0.014			
D	9.000	9.400	0.354	0.370			
E	6.200	6.600	0.244	0.260			
E1	7.320	7.920	0.288	0.312			
е	2.540(BSC)		0.100	(BSC)			
L	3.000	3.600	0.118	0.142			
E2	8.400	9.000	0.331	0.354			

GN Semi conductor (Shanghai) Co., Ltd.

### GNV321/358/324A

#### 7.4、SOP-14**外形图与封装尺寸**

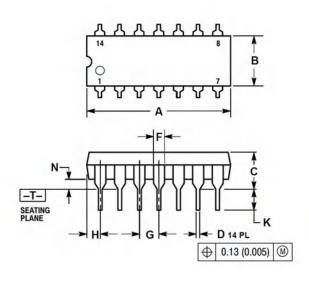


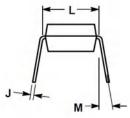
- NOTES:
  1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
- Y14.5M, 1982.
  2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
- DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION.
   MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
- 4. MAXIMUM MOLD PHOTRUSION 0.15 (0.006) PER SIDE.

  5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.

	MILLIM	ETERS	INCHES		
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX	
Α	8.55	8.75	0.337	0.344	
В	3.80	4.00	0.150	0.157	
C	1.35	1.75	0.054	0.068	
D	0.35	0.49	0.014	0.019	
F	0.40	1.25	0.016	0.049	
G	1.27	BSC	0.050 BSC		
J	0.19	0.25	0.008	0.009	
K	0.10	0.25	0.004	0.009	
M	0 °	7°	0 °	7°	
Р	5.80	6.20	0.228	0.244	
R	0.25	0.50	0.010	0.019	

#### 7.5、DIP-14外形图与封装尺寸





#### NOTES:

- DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
- CONTROLLING DIMENSION: INCH.
  DIMENSION L TO CENTER OF LEADS WHEN
- FORMED PARALLEL.
- DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH.
- 5. ROUNDED CORNERS OPTIONAL.

	INC	HES	MILLIMETERS		
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.715	0.770	18.16	18.80	
В	0.240	0.260	6.10	6.60	
С	0.145	0.185	3.69	4.69	
D	0.015	0.021	0.38	0.53	
F	0.040	0.070	1.02	1.78	
G	0.100	BSC	2.54 BSC		
Н	0.052	0.095	1.32	2.41	
J	0.008	0.015	0.20	0.38	
K	0.115	0.135	2.92	3.43	
L	0.290	0.310	7.37	7.87	
M		10°		10°	
N	0.015	0.039	0.38	1.01	

GN Semi conductor (Shanghai) Co., Ltd.

GNV321/358/324A

#### 8、声明及注意事项

#### 8.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素									
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六阶铬 (Cr (VI ))	多溴联 苯 (PBBs )	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基巳 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
引线框	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塑封 树脂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芯片	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内引线	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装片胶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
说明	○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

#### 8.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料仅供参考,本公司不作任何明示或暗示的保证,包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权 利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备,也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害 、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险,本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试,以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障 。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利,本资料中的信息如有变化,恕不另行通知, 建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料,如果由本公司以外的来源提供,则本公司不对其内容负责。